3E15

単鎖磁石ヒドロニトロニルニトロキシド・コバルト(II)錯体と

その関連物質の構造と磁性

(電通大量子物質工) 〇石井憲雄, 石田尚行, 野上隆



【序】現在までに遷移金属とNN(ニトロニルニトロキシド)の鎖状錯体に はバルクの磁性体になった例¹⁾と単鎖磁石になった例²⁾が報告されている。 今回は単鎖磁石になった例と同様に、金属には磁気異方性の大きい Co(hfac)₂を、そして配位子にはより嵩の小さいHNNを使用して強い相互 作用を持たせ、高いブロッキング温度の単鎖磁石を作ることに成功した。 またHNN以外のNNとして、文献にある *p*-AnNN や鎖長の異なる

 $C_nH_{2n+1}NN$ を用いて Co(hfac)₂と錯体を形成し単鎖磁石のメカニズムの究明をめざしている。 【結果と考察】Co(hfac)₂と HNN を1:1の比率で混合することで錯体を形成し、濃青色の板状 結晶(α)及び針状結晶(β)得た。その結晶のX線構造解析により構成分子が交互に連な った1次元鎖錯体が形成されていることを明らかにした (Fig.1)。

α相 (*b*軸方向に鎖が伸びている)

monoclinic $P2_1/c$ a=10.587Å b=11.919Å c=19.215Å $\beta=102.10^\circ$ R=0.070 β相 (*a-c* 軸方向に鎖が伸びている)



monoclinic C2/c a=25.926 Å b=11.611 Å c=24.587 Å $\beta=99.573^{\circ}$ R=0.068

Fig.1 X線構造解析結果。● は cis ■ は trans 配座を示す。

それぞれの錯体の単結晶に対して磁気異方性を調べた結果、α、β相ともに鎖方向に磁化 容易軸を持つフェリ磁性鎖であることが解った。α相の直流及び交流磁気測定結果をそれぞ れ Fig.2,3 に示す。磁化には緩和が見られ、これは単鎖磁石挙動と考えられる。また、交流磁 化率χ"に周波数依存性がみられ、このピークを用いてアレニウスプロットを行った (Table1)。



Fig.2 α相単結晶に磁場を b 軸方向にかけた時の(a) FCM,RM,ZFCM (H=5Oe) (b) M-H曲線(T=1.8K)



Fig.3 α 相単結晶の磁場 b 軸方向の交流磁化率(χ ': in-phase χ ": out-of-phase)

	Mn(hfac) ₂ -HNN	$Co(hfac)_2$ -HNN(α)	$Co(hfac)_2$ -HNN(β)	Co(hfac) ₂ -p-AnNN
Configuration	cis	cis	cis,cis,trans	cis
M-O(Radical)	2.145 Å	2.084 Å	2.069 Å	2.103 Å
M…M intrachain	7.100 Å	6.868Å	6.509 Å	7.818 Å
M…M interchain	7.203 Å	9.045 Å	9.406 Å	11.289 Å
$\Delta/k_{\rm B}$		193K	71K	154K
τ ₀		$1.3 imes 10^{-12}$	1.1×10^{-10}	$3.0 imes 10^{-11}$
T _B		5K	2K	4K
$T_{ m N}$	4.6K	10K	4K	
磁性	バルク磁石	バルク+単鎖	バルク+単鎖	単鎖磁石

この錯体は単鎖磁石挙動を示す一方で、RM の経時変化を追跡したところ、残留磁化において減衰する成分と保持し続ける成分とがあることが解った。つまりバルク磁石的側面も認めることができた。Table1 で示すようにHNNを使用することで鎖内での M…M 間および M-O(radical)間距離を縮めることができその結果、高いエネルギー障壁及び、転移温度につながったと考えられる。

また、この鎖状錯体の鎖間距離がバルクの磁性体と純粋な単鎖磁石の間の値であり、このこ とはバルク磁石と単鎖磁石の両面性を持つ事と矛盾しない。

現在、配座、鎖間距離、鎖内 M-M 間および M-O(radical)間距離がエネルギー障壁などに与 える影響を明らかにするためにHNN以外のNN(i-Pr NNなどHNNよりも嵩の大きい配位 子)と Co(hfac)₂の錯体を合成し磁気測定などを進めている。

References

1). T. Ise et al., *Inorg. Chem*, **2003**, *42*, 6106.

2). A. Caneschi et al., Angew. Chem. Int .Ed, 2001, 40, 1760.